

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский

университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

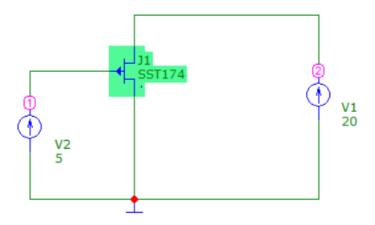
Отчет по лабораторной работе №7

«Полевые транзисторы»

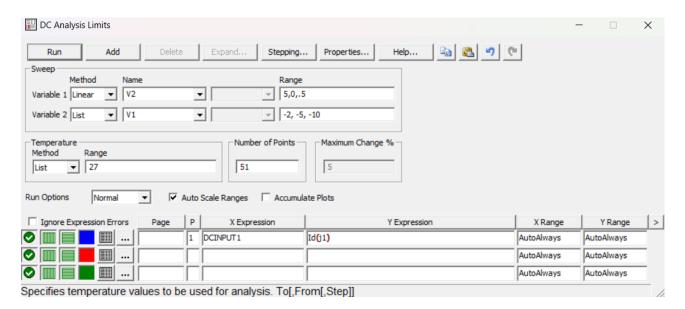
Студент:	Платонова Марина Игоревна				
Группа:	ИУ7-31Б				
Вариант:	92				
Название предприятия НУК ИУ МГТУ им. Н. Э. Баумана					
Студ	цент <u>Платонова М.И</u>	<u>1.</u>			
Прег	подаватель <u>Оглоблин Д.І</u>	<u>1.</u>			
Оцен	нка				

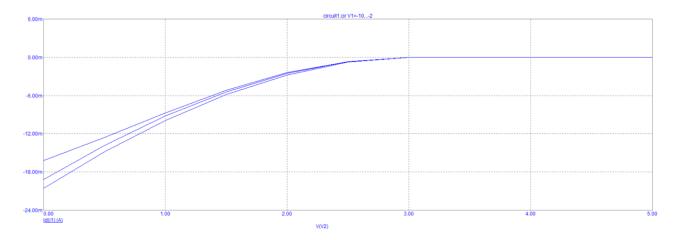
Эксперимент 7

PNP JFET SST174:



Передаточная характиристика:





Uотс = 3B – напряжение отсечки

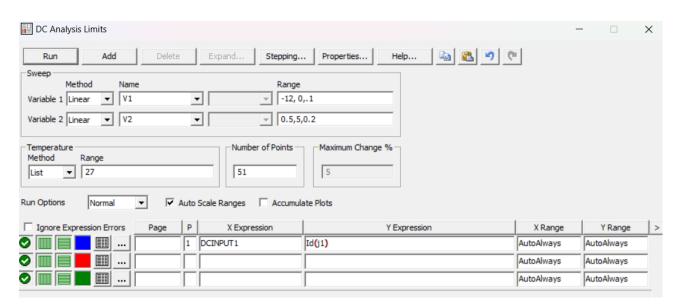
Крутизна:

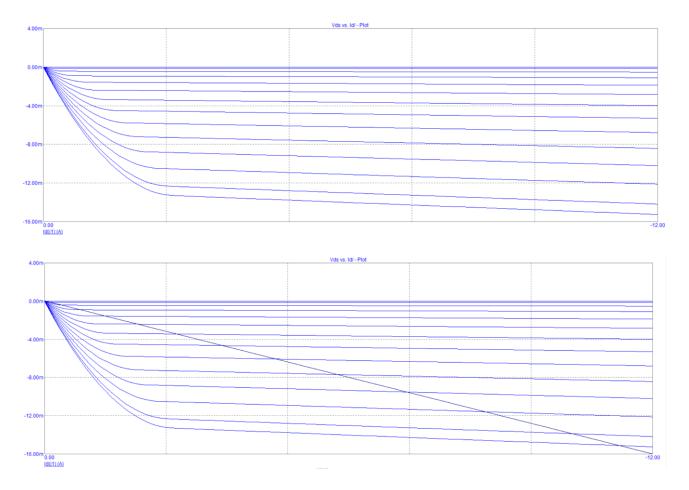
$$S_{max} = \frac{2I_{\text{Haq}}}{U_{\text{OTC}}}$$

Расчет крутизны транзистора:

Напряжение U, B	Сила тока I, мА	Крутизна Smax, мА/В
2	16	5.3
5	19	6.3
10	20	6.6

Выходная характеристика:

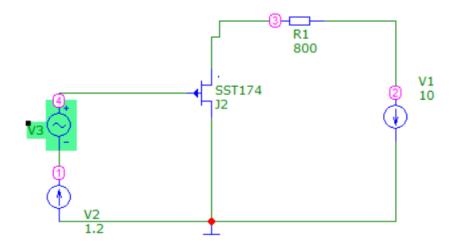


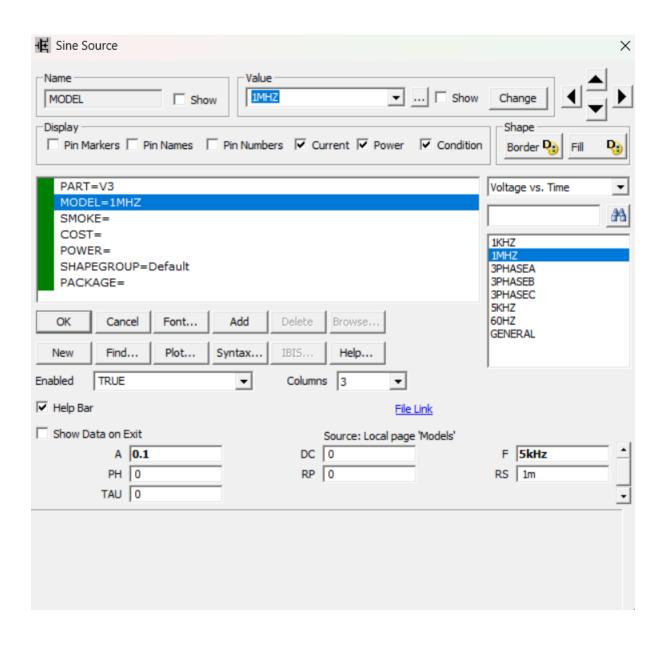


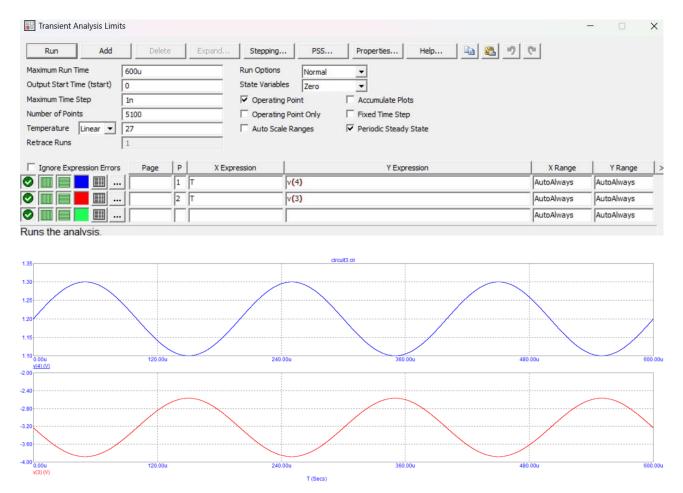
Возьмем рабочаю точку: V = 6B, I = 7.5мA, Vgs = 1.2B

$$R = \frac{(E_{\text{пит}} - U)}{I} = 800 \text{ Om}$$

Соберем усилитель:





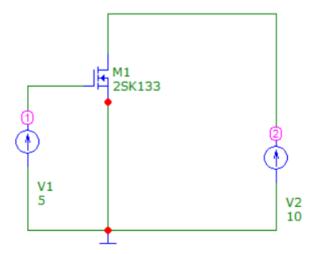


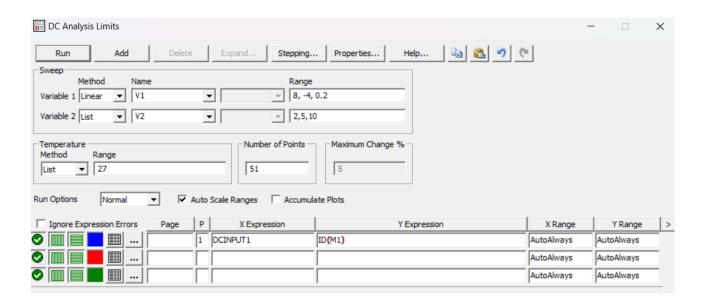
$$A_{\text{дo}} = 1.3 - 1.1 = 0.2B$$

$$A_{\text{после}} = 3.9 - 2.5 = 1.4B$$

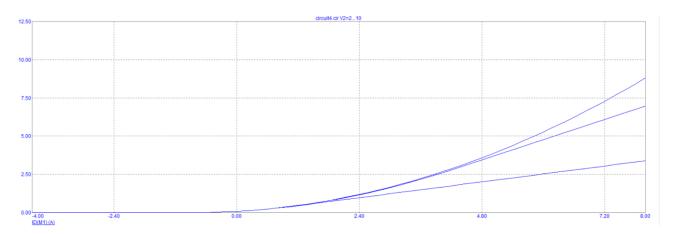
$$K = \frac{A_{\text{после}}}{A_{\text{до}}} = 7$$

Nmos 2SK133:



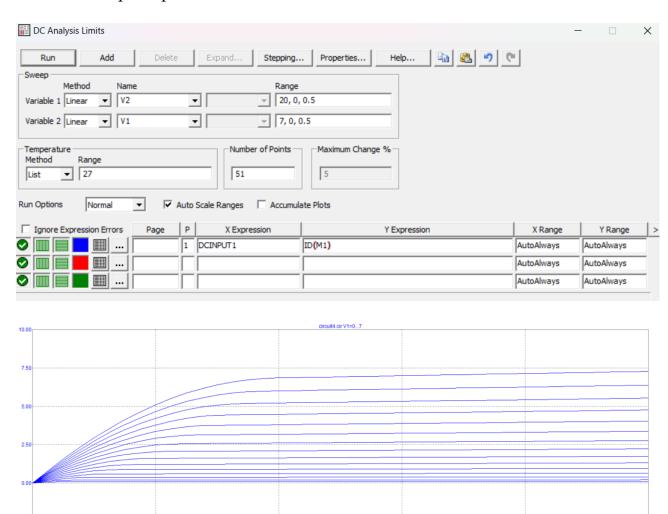


Переходная характеристика:

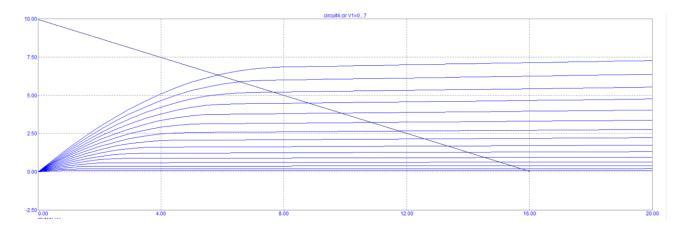


Uоткp = 0.5B

Выходная характеристика:



Проведем нагрузочную прямую:

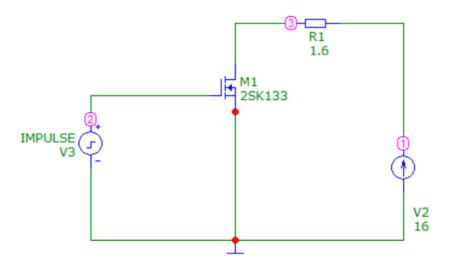


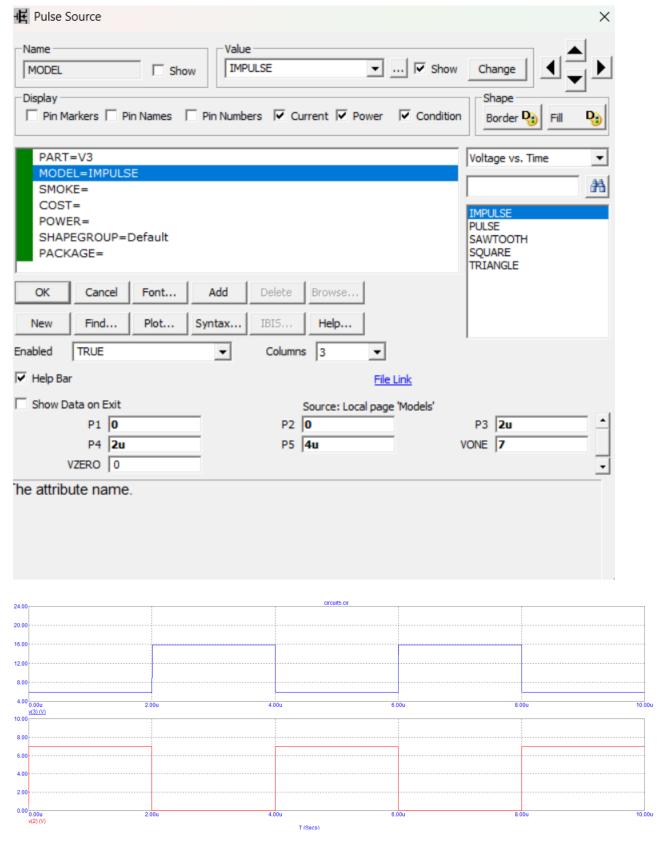
$$I = 10A, E = 16B.$$

$$R = 16/10 = 1.6 \text{ Om}$$

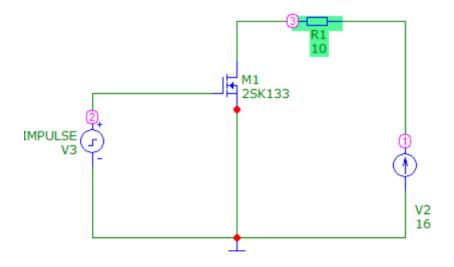
Vgs = 7 B

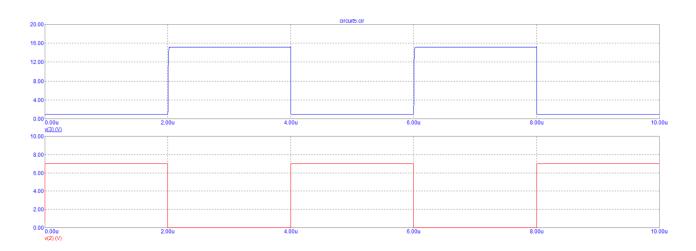
Соберем ключ:





Напряжение в открытом состоянии 6В > 1.5В, увеличим сопротивление:

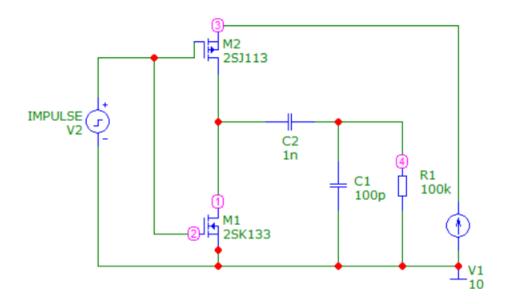


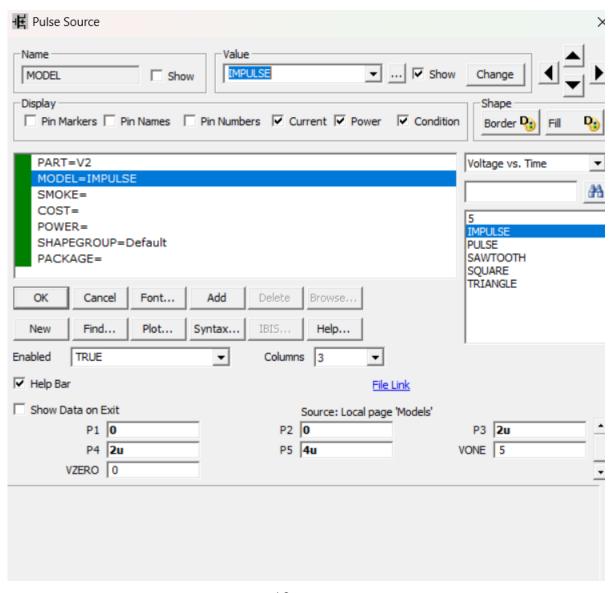


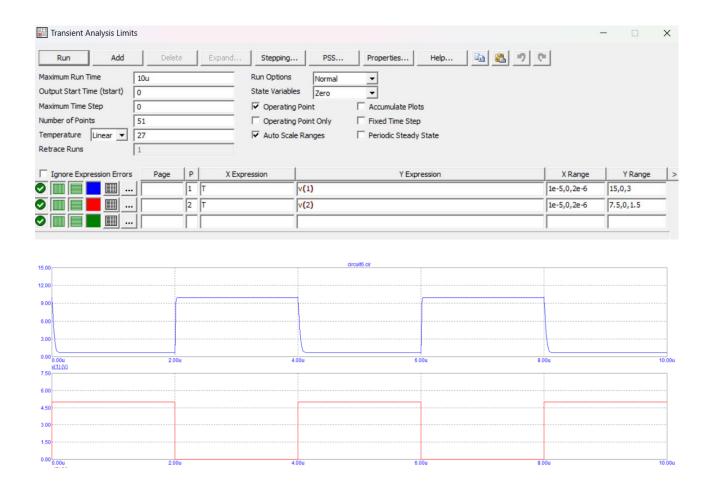
Теперь напряжение в открытом состоянии $0.8~\mathrm{B} < 1~\mathrm{B}.$

Эксперимент 8

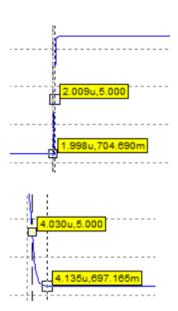
Соберем цифровой ключ КМОП:







Задержки:

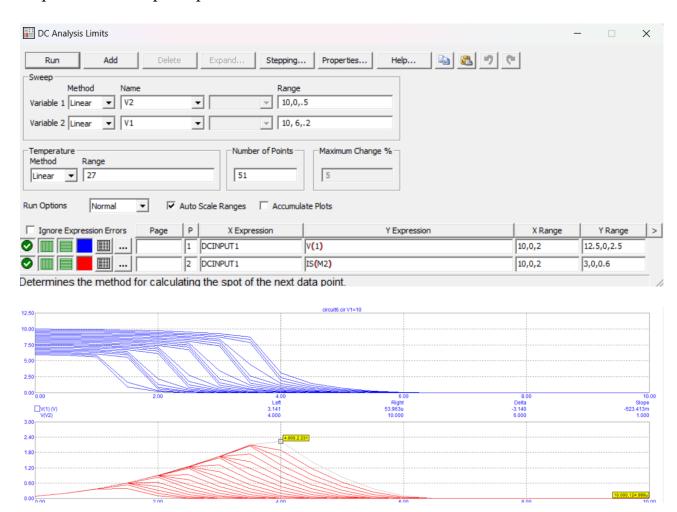


 T_{01} =0.011мкс

 $T_{10} = 0.105$ мкс

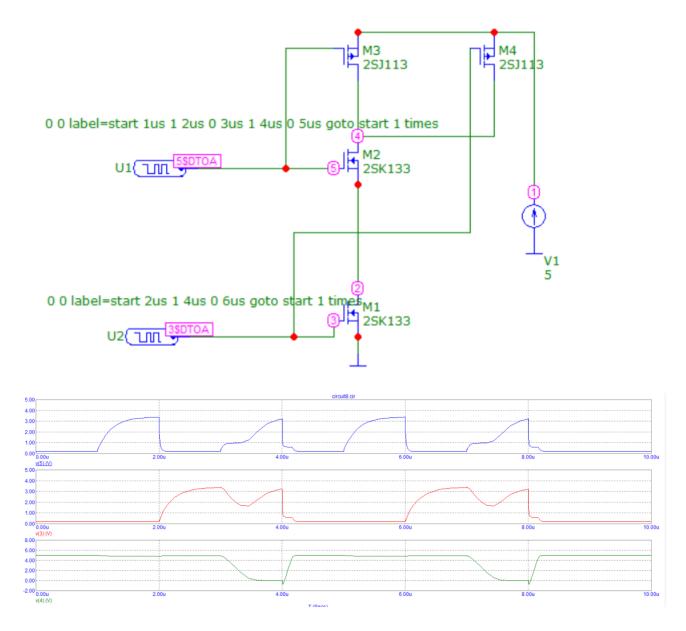
 $T_{\text{зад}} = 0.058$ мкс

Передаточная характеристика:

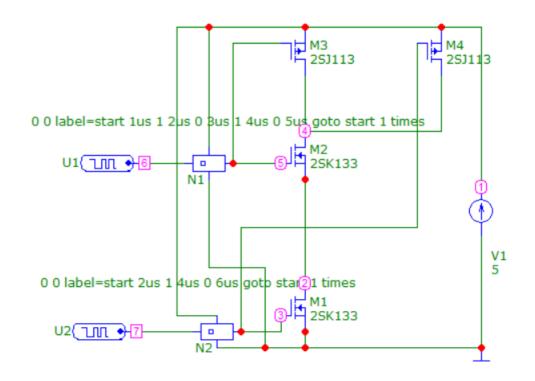


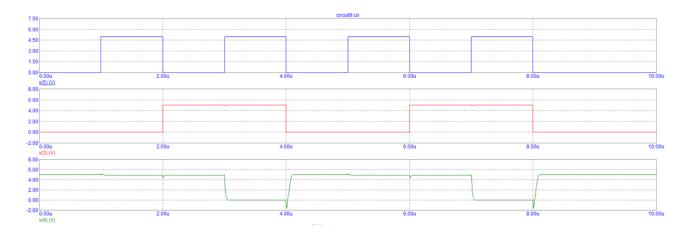
Максимальный ток при 10В – 2.2А

Схема НЕ-И:



В данной схеме не правильно вводятся входные сигналы, поэтому добавим интерфейсы токов:





Получена корректная схема НЕ-И.

Обозначение НЕ-И:

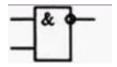


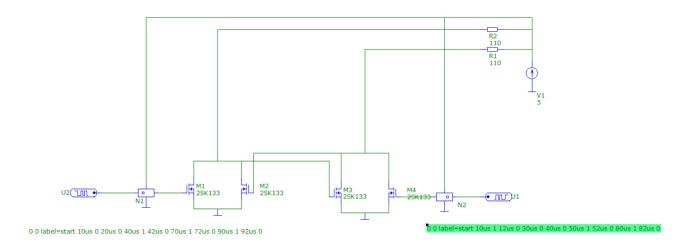
Таблица истинности:

X	Y	НЕ Х И Ү
0	0	1

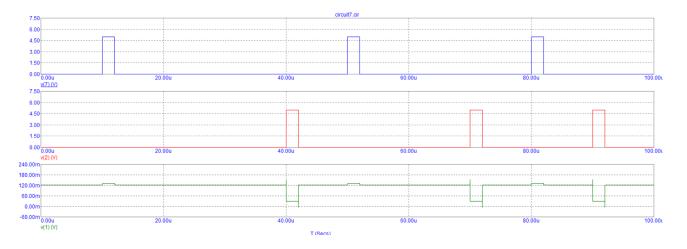
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Эксперимент 9

Создадим триггер на nmos транзисторах:



Полученная картина:



К сожалению, этот триггер не заработал.